(1) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭60-14148

⑤Int. Cl.4
G 01 N 27/12

識別記号

庁内整理番号 6928-2G **3公開 昭和60年(1985)1月24日**

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

60ガスセンサ

20特

願 昭58-123047

②出 願 昭58(1983)7月5日

@発明者山元稔

西尾市下羽角町岩谷14番地株式 会社日本自動車部品総合研究所 内

@発 明 者 服部正

西尾市下羽角町岩谷14番地株式

会社日本自動車部品総合研究所

仍発 明 者 向中野信一

西尾市下羽角町岩谷14番地株式 会社日本自動車部品総合研究所 内

⑪出 願 人 株式会社日本自動車部品総合研究所

西尾市下羽角町岩谷14番地

份代 理 人 弁理士 伊藤求馬

明知由

1. 発明の名称

ガスセンサ

2. 特許請求の範囲

(1)金配酸化物半導体よりなり、還元性ガスに感応する一対のガス感応体を基板上に形成するとともに、上記ガス感応体の一方はこれを水蒸気透過性かつ遠元性ガス不透過性のガス阻止層で覆い、一方上記両ガス感応体の出力差よりガスを度を知る測定回路を設けたことを特徴とするガスセンサ。

(2)上記ガス阻止図は多孔質絶縁膜の外面に ガス酸化触媒膜を形成してなる特許請求の範囲第 1項記載のガスセンサ。

(3) 上記ガス感応体は、金属酸化物半導体たる酸化スズに負金属たるパラジウムあるいは自金を添加してなるスラリーをセラミック基板上に印刷、競成して形成した特許請求の範囲第1項記載のガスセンサ。

(4)上記多孔賢絶縁顕は粒径0.1μmない

し数十 μ ■ のアルミナ、酸化マグネシゥム等の金属酸化物粉よりなるスラリーを上記ガス感応体の表面に印刷、焼成して形成した特許新求の範囲第2項記載のガスセンサ。

(5) 上記ガス酸化無媒膜は白金、バラジウム、ロジウムあるいはニッケル等の金属触媒の一種もしくは複数種をアーアルミナ等の比表面段の大きな物質に担持せしめてなるスラリーを上記多孔質絶数膜の表面に印刷、焼成して形成した一般化炭素ガス酸化焼媒膜である特許請求の範囲第2項記録のガスセンサ。

3. 発明の詳細な説明

本発明は金属酸化物半導体を使用して選元性がスを検出するガスセンサに関するものである。

この種のセンサは車室等に設置して一酸化炭素 (CO)ガスを検出することにより簡便に雰囲気 の汚染度を知る等の目的に使用されるが、雰囲気 湿度によってセンサ出力が変動するという問題が

この問題を解決するために種々の提案がなされ

ており例えば水 悉気 日に応じて抵抗 値が減少する n 型半導体と、水 然気 量に応じて抵抗 値が 増大する p 型半導体とを接合して 湿度による影響を相段 するようにした ガスセンサが 堤 案 されているが (特公 昭 5 0 - 1 0 7 5 7 号)、この 協合には 湿度に対して全く対称的な抵抗特性を有する半導体を のなり、 製作が簡単でかつ精度の良いガスセンサは未だ実現していない。

本発明は上記問題点に鑑み、製作が簡単で、しかも程度の影響を受けることなく正確にガス改度を選定できるガスセンサを提供することを目的とするものである。

すなわち、本発明のガスセンサは金配酸化物半 な体よりなり、遠元性ガスに感応する一対のガス 感応体を基板上に形成するとともに、上記ガス感 応体の一方はこれを水蒸気透過性かつ遠元性ガス 不透過性のガス阻止圏で罹い、一方上配両ガス感 応体の出力差よりガス濃度を知る測定回路を設け たものである。

ために形成したものである。

上配約級膜3b の表面はさらにガス酸化無螺膜4で狙つてある。

上記酸化触媒脱4は水蒸気を支障なく適適せしる。とともに退元性ガスは酸化して非認元性ガスは酸化して非認元なカスを認定対象ガスする場合にはPt、Pd、ロジウム(Rh)あるいはニッケル(Ni)等の金属触媒の一種もしるはは数種をアーアルミナ(アーAl2 O3)等のの出版がある。

なお、ガス感応休2a、2bからはそれぞれ Pしあるいは銀(Ag)よりなるリード用電極2 1、22、23、24が延出形成してある。上記 電極21~24には後述する測定回路に至るリー ド線が接続される。

 以下、図示の実施例により本発明を説明する。第1図、第2図において、アルミナあるのとフェライト等のセラミックよりなる基板1の企工には関係を留いてガス感応体2a、2bが形で、のは同一組成で、すれる金属で体2a、2bは同一組成で、すれる金属でなり、あるいは自立に、シリカにののバインダと海剤を加えてスラリー状となる。

上記ガス感応休2a、2bはそれぞれ多孔質絶級膜3a、3bで狙つてある。絶縁膜3a、3bは、いずれも粒径0.1μm~数+μmのアルミナ(A2203)あるいはマグネシア(MgO)等の金属酸化物粉を上記同様スラリー状となし、これを感応体2a、2bの表面に印刷形成したものであり、電気絶縁性を有し、かつ遠元性ガスおよび水蒸気は支降なく洒過する。

なお、ガス感応休2aを留う絶縁製3a は、資 感応体2a、2b の湿度雰囲気をほぼ用じにする

抵抗体あるいはPTC抵抗体を禁板1に印刷、焼成して形成する。ヒータ5にはリード用配極51、52により電力が供給される。

第3図には別定回路6を示す。ガス感応休2a、2b はそれぞれ測定回路6中の抵抗器61、62に直列に接続してあり、各接続点の分圧電圧 Va、Vb がそれぞれ差砂アンプ63の「+ J 入力端子、「- J 入力端子に入力してある。これにより、測定回路6からは上記分圧電圧 Va、Vb の差電圧Vc が出力される。図中Vs は電源である。

上記の如き構造を有するガスセンサの作動を以 下に説明する。

第4 図にはセンサを 設けた 雰叨気中の 程度変化に伴なうガス感応体 2 a 、 2 b の抵抗値変化を示す。 図中線× 、 y はそれぞれ上記感応体 2 a 、 2 b の抵抗値変化を示し、図より知られる如く、両感応体 2 a 、 2 b の抵抗値変化の傾向はほぼ同じである。 すなわち、同一の温度変化領域(図中 Δ H における感応体 2 a 、 2 b の抵抗値変化のである。

2 a 、 2 b の抵抗値に差が生じるのは酸化触媒膜 4 (第 1 図参照)の有無による。

上記の如く、感応体2a、2bの抵抗値変化分
AR1、AR2 はほぼ等しいから、測定回路6
(第3図参照)の抵抗値61、62の抵抗値を適当に選択することにより、第5図に示す如く分圧電圧Va、Vbは湿度に関係なく一致せしめることができる。この結果、測定回路6の出力電圧Vcは湿度に無関係に0Vとなる。

ここで、選元性ガス(木実施例の場合は C O ガス) 讃度が変化すると、ガス讃度の増大に伴なってガス感応体 2 a 、 2 b の抵抗値は減少する。 C O ガスは酸化触媒膜 4 を通過する間にそのうちの大部分が酸化されて C O2 ガスに変換される。 したがって感応体 2 b に到達する C O ガスは感応体 2 b の抵抗値の変化は小さい。

これにより、第6図に示す如く、ガス改度の増 大に伴なって分圧電圧Va の変化は分圧電圧Vb

以外に、 ア・二酸化マンガン(アーMn O₂)、酸化銀(Ag O) および酸化銅(Cu O)を主成分とした一般名ポプリカット触媒、酸化クロム(Cr₂ O₃) + A L₂ O₃ 系触媒、形化鉄(Fe₂ O₃) + A L₂ O₃ 系触媒等が使用できる。

また、酸化触媒は測定対象ガスに応じて、例えばHCガスに対してはHC酸化触媒を使用する等、 適当なものを選択すれば良い。

以上の如く、本発明は複度の影響を受けることなく商精度で、かつ製作も容易な遠元性ガスのガスセンサを実現したもので、特に車室等のCOガス複度を測定して換気装置を作動させる等の用途に使用して最高である。

4. 図面の簡単な説明

第1図はセンサの全体断而図で、第2図のI-I操に沿う断面図、第2図はセンサの上方より見た平面図、第3図は測定回路の回路図、第4図は湿度に対する感応体の抵抗値変化を示す図、第5図は湿度に対する測定回路の各部電圧変化を示す

また、本発明によれば特性の等しい同一相成の ガス感応体を得ることは容易であり、しかもセン サ本体はセラミックの焼成体であるから製作が容 易である。

なお、COガスの酸化触媒としては上記実施例

図、第6図はガス濃度に対する測定回路の各部態 圧変化を示す図である。

1 抵板

2 a 、 2 b … … ガス感応休

3 a 、 3 b … … 多孔質絶縁股

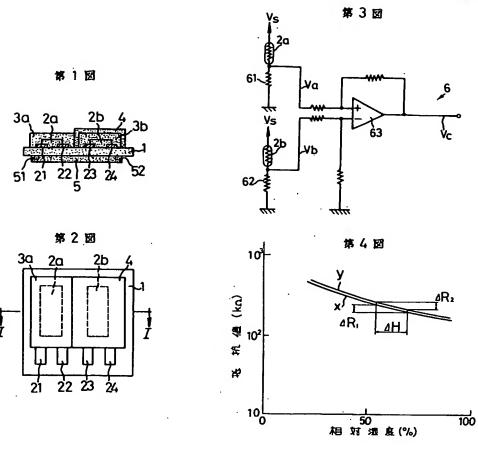
4 … … ガス酸化触媒膜

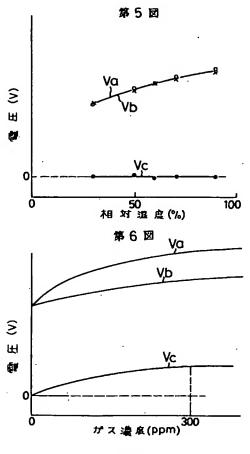
5 … … ヒータ

6 … … 測定回路

代理人 弁理士 伊 厳 求 [







L9 ANSWER 87 OF 98 CA COPYRIGHT 2005 ACS on STN

AN 102:159753 CA

TI Gas sensor

PA Japan Auto Parts Industries Assoc., Japan

SO Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 4 pp.

PI JP 60014148 A2 19850124 JP 1983-123047 19830705

PRAI JP 1983-123047 19830705

AB A gas sensor (e.g., H or CO sensor) free from the adverse effects of moisture consists of the following: (1) a pair of gas-sensitive bodies from a metal oxide semiconductor (e.g., Pd or Pt activated SnO2) sensitive to a reducing gas on a substrate; (2) a gas-blocking layer (which is permeable to moisture but not to reducing gases) on 1 of the gas-sensitive bodies; and (3) a measurement circuit which dets. the reducing gas based on the differences of the output of the gas-sensitive bodies. Addnl., a gas-oxidn. catalyst film such as Pt, Pd, Rh, and/or Ni can be provided on the gas-blocking layer. Optionally, the gas-blocking layer can consists of a porous insulator film from a metal oxide such as Al2O3 or MgO.

PAT-NO: JP360014148A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60014148 A

TITLE: GAS SENSOR

PUBN-DATE: January 24, 1985

INVENTOR-INFORMATION: YAMAMOTO, MINORU; HATTORI, TADASHI; KONAKANO,

SHINICHI

ASSIGNEE-INFORMATION: NIPPON SOKEN INC

APPL-NO: JP58123047 APPL-DATE: July 5, 1983

ABSTRACT:

PURPOSE: To realize high precision of the title sensor without influence of humidity by forming a pair of gas-sensitive bodies made of metal oxide semiconductor and sensible to reducible gas on a substrate.

CONSTITUTION: The gas-sensitive bodies 2a, 2b are formed at an interval on an upper surface of the substrate 1 made of ceramic. The bodies 2a, 2b have the same composition, to powder in which noble metals such as palladium or platinum are added to tin oxide of metal oxide semiconductor and activated, a binder such as silica sol, and flux are added to obtain the slurry state, the resulting product is printed on the substrate 1 and ignited to form the bodies 2a, 2b. The gas-sensitive bodies are covered respectively with porous insulating films 3a, 3b. The surface of the film 3b is covered with a film 4 of gas oxidizing catalyzer. Leading electrodes 21, 22, 23, 24 made of platinum and silver are extended from the bodies 2a, 2b. A heater 5 is formed at the under surface of the substrate 1.